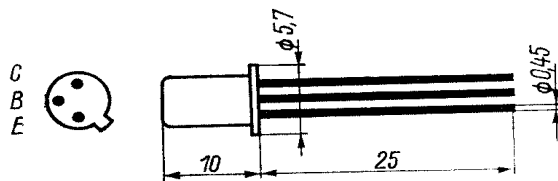


Germanium-pnp-Transistor der Bauform A 3/25-b nach TGL 11 811 für rauscharme Verstärker, Misch- und Oszillatorstufen im Nieder- und Mittelfrequenzgebiet.



Masse ca. 0,8 g

Wärmewiderstand

$R_{thja} \leq 1 \text{ grad/mW}$

**Grenzwerte; gültig für den Betriebstemperaturbereich**

Kollektor-Basis-Spannung	$-U_{CBO} = 15 \text{ V}$
Emitter-Basis-Spannung	$-U_{EBO} = 10 \text{ V}$
Kollektorstrom	$-I_C = 15 \text{ mA}$
Emitterstrom	$I_E = 15 \text{ mA}$
Basisstrom	$-I_B = 5 \text{ mA}$
Gesamtverlustleistung	$P_V = 50 \text{ mW}$ bei $\vartheta_a = 25^\circ \text{C}$
Sperrschichttemperatur	$\vartheta_j = +75^\circ \text{C}$
Betriebstemperaturbereich	$-25^\circ \text{C bis } +65^\circ \text{C}$

**Statistische Kennwerte**

		Min.	Typ	Max.
Kollektor-Basis-Reststrom	$-I_{CBO}$		1,5 $\mu\text{A}$	15 $\mu\text{A}$
$-U_{CB} = 6 \text{ V}$				
Kollektor-Basis-Reststrom	$-I_{CBO}$		50 $\mu\text{A}$	500 $\mu\text{A}$
$-U_{CB} = 25 \text{ V}$				
Kollektor-Emitter-Reststrom	$-I_{CEO}$		55 $\mu\text{A}$	600 $\mu\text{A}$
$-U_{CE} = 6 \text{ V}$				
Emitter-Basis-Reststrom	$-I_{EBO}$		50 $\mu\text{A}$	500 $\mu\text{A}$
$-U_{EB} = 15 \text{ V}$				

**Dynamische Kennwerte**

		1 MHz	2,1 MHz	
Grenzfrequenz	$f_{h21b}$			Stromverstärkungsgruppe
$-U_{CB} = 6 \text{ V}$				
$-I_C = 1 \text{ mA}$				
$f = 3 \text{ MHz}$				
Kurzschlußstromverstärkung	$h_{21e}$	18	35	a
$-U_{CE} = 6 \text{ V}$		28	56	b
$-I_C = 2 \text{ mA}$		45	90	c
$f = 1 \text{ kHz}$		71	140	d
		112	224	e
Rauschmaß	F		5 dB	10 dB

$-U_{CE} = 1 \text{ V}$
$-I_C = 0,2 \text{ mA}$
$f = 1 \text{ kHz}$
$\Delta f = 1 \text{ kHz}$
$R_g = 500 \Omega$

Bestellbeispiel für einen Transistor  
der Stromverstärkungsgruppe b

Transistor GC 101 b